

А. А. ЛУКЬЯНОВ

К ТЕОРИИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ СВЕРХРЕШЕТКИ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ С ГОРЯЧИМИ ЭЛЕКТРОНАМИ

Введение. В работе [1] была поставлена и в линейном приближении решена задача о возникновении температурной сверхрешетки в полупроводниках с униполярной проводимостью в условиях достаточно большого градиента электронной (или дырочной) температуры. Предполагалось, что газ свободных носителей заряда нагревается полем световой волны в процессе внутризонного поглощения света. Электронный газ считался несжимаемым, а коэффициент поглощения γ — независимым от электронной температуры T . В настоящей работе рассматривается та же задача, что и в [1], но в условиях, когда нельзя пренебречь зависимостью коэффициента поглощения света от электронной температуры. В остальном мы пользуемся теми же предположениями, что и в [1]. В частности, будем считать, что толщина образца в направлении светового потока значительно превышает обратное значение коэффициента поглощения слабой электромагнитной волны γ_0^{-1} , а

$$\gamma_0^{-1} \gg \lambda_0^{-1} = \sqrt{\frac{2}{3} \kappa_0 \tau_0}.$$

Легко понять, какого эффекта здесь следует ожидать. Учет указанной зависимости при $\frac{d\gamma}{dT} > 0$ приведет к тому, что коэффициент поглощения несколько повысится у освещенной поверхности по сравнению с тем случаем, когда зависимостью $\gamma(T)$ пренебрегали. При этом увеличится (уменьшится) количество световой энергии, поглощенной у поверхности (прошедшей в глубь образца). Таким образом, здесь следует ожидать несколько больших перепадов электронной температуры. Соответственно при $\frac{d\gamma}{dT} > 0$ неустойчивость наступит при меньших значениях интенсивности света, чем ожидалось в задаче без учета зависимости $\gamma(T)$. При $\frac{d\gamma}{dT} < 0$ ситуация будет обратной.

§ 1. Основные уравнения. Исходными уравнениями для нас будут те же, что и в [1]. Отличие состоит лишь в выражении для энергии световой волны, поглощаемой единицей объема в единицу времени.

Введем следующие обозначения: n — концентрация свободных носителей заряда (в дальнейшем мы называем их электронами, хотя и пишем все формулы для частиц с положительным зарядом); u — скорость конвекционного движения; κ — температуропроводность; τ — время релаксации энергии; q — плотность потока энергии электронов; I — поток световой энергии; T и T_0 — электронная температура и температура решетки; $-\nabla\phi$ — напряженность постоянного электрического поля; E_{\perp} — напряженность поля световой волны; j_{\perp} — плотность тока, обусловленного электромагнитной волной; σ — проводимость.

Если электронный газ несжимаем и невырожден, а зависимость времени релаксации импульса от энергии W степенная ($\tau_p(W) \sim W^r$), то, как известно, уравнение переноса энергии имеет вид:

$$\frac{3}{2} n \frac{\partial T}{\partial t} + \left(\frac{5}{2} + r \right) n \operatorname{div}(\mathbf{u}T) - n \operatorname{div}(\kappa \nabla T) + \\ + en(\mathbf{u}, \nabla \varphi) + \frac{3}{2} n \frac{T - T_0}{\tau} = n \langle \dot{W} \rangle. \quad (1)$$

Слагаемое $n \langle \dot{W} \rangle$ описывает среднюю энергию, приобретаемую единицей объема электронного газа в единицу времени от поля световой волны.

Если световая волна монохроматична, т. е.

$$\mathbf{E}_\sim = \operatorname{Re} [\mathbf{E}_0 e^{-i\omega t}], \quad \mathbf{j}_\sim = \operatorname{Re} [\mathbf{j}_0 e^{-i\omega t}],$$

то

$$n \langle \dot{W} \rangle = \langle \mathbf{j}_\sim \mathbf{E}_\sim \rangle = \frac{1}{2} \sigma_r(T) |E_0|^2.$$

Таким образом, чтобы получить выражение для $n \langle \dot{W} \rangle$, необходимо решить уравнения Максвелла с учетом зависимости проводимости σ ($\sigma = \sigma_r + i\sigma_i$) от электронной температуры. Эта зависимость считается известной из кинетической теории (см., например, [2]).

Граничные условия к уравнению (1) те же, что и в [1]. Если ось Oz совпадает с направлением светового потока, то

$$z = 0: \quad -n\kappa \frac{\partial T}{\partial z} = -n\nu(T - T_0),$$

$$z \rightarrow \infty: \quad T \rightarrow T_0,$$

где $\nu > 0$ — феноменологический коэффициент. Сразу будем считать (в [1] это условие пришлось наложить в конце), что теплоотвод на освещенной границе мал, так что $\nu'_0 = \nu_0 \kappa_0^{-1} \lambda_0^{-1} \ll 1$. Положим

$$T = T_0(1 + \xi)$$

и будем считать, что перегрев мал, т. е. $\xi \ll 1$. Поэтому в дальнейшем по ξ везде будет производиться линеаризация. Учитывая сказанное, ограничимся в разложении $\sigma(\xi)$ в ряд Тэйлора членами не выше первого порядка по ξ , т. е.

$$\sigma(\xi) = \sigma_0 + \sigma_0 \dot{\sigma}_0 \xi,$$

где через $\dot{\sigma}_0$ обозначена логарифмическая производная $\dot{\sigma}_0 = \left(\frac{d \ln \sigma}{d \ln T} \right)_{T=T_0}$.

§ 2. Статический случай. В условиях, когда неустойчивость еще не наступила, решение следует искать в виде

$$\mathbf{u} = 0, \quad \xi = \xi_s(z), \quad \varphi = \varphi_s(z), \quad \mathbf{E}_0 = \mathbf{E}_{s0}(z) \parallel Ox.$$

При этом уравнение (1) принимает вид

$$-nT_0 \xi_s'' - nT_0 \frac{(\xi_s')^2}{1 + \xi_s} \dot{\kappa} + \frac{3}{2} nT_0 \frac{\xi_s}{\tau} = \frac{1}{2} \sigma_r(\xi_s) |E_{s0}|^2. \quad (2)$$

Совместное решение уравнений Максвелла и (2) дает [2]

$$E_{s0}(z) = E_m e^{iq\tilde{a}z - \gamma_0 z/2} \exp \left\{ i \frac{q}{2} \frac{d\xi(0)}{\varepsilon(0)} \int_0^z \xi_s dz' - \frac{1}{4} \frac{d\xi(0)}{\varepsilon(0)} [\xi_s(z) - \xi_s(0)] \right\}$$

и (в линейном по ξ_s приближении)

$$\xi_s(z) = \frac{\sigma_{r0} |E_m|^2}{3nT_0\tau_0^{-1}} [e^{-\nu_0 z} - (\nu_0 + \gamma_0 \lambda_0^{-1}) e^{-\lambda_0 z}].$$

Здесь

$$\bar{n}_0 + i\gamma_0/2q = \sqrt{\varepsilon(\omega, 0)}, \quad q = \omega/c, \quad \varepsilon(\omega, \xi) = \varepsilon_l(\omega) + i4\pi\sigma(\omega, \xi)/\omega.$$

Через $\varepsilon_l(\omega)$ обозначена часть диэлектрической проницаемости, обусловленная поляризацией атомов и колебаниями ионов решетки и не зависящая от электронной температуры. $E_m = E_{s0}(0)$. Значение E_m определяется из условия непрерывности тангенциальной составляющей электрического поля на границе $z=0$.

§ 3. Температурная сверхрешетка. Для исследования устойчивости статического состояния относительно возникновения сверхрешетки наложим на статическое решение малое возмущение, полагая

$$\xi = \xi_s + \delta\xi, \quad \varphi = \varphi_s + \delta\varphi, \quad \mathbf{u} = \mathbf{u}_s + \delta\mathbf{u} (\mathbf{u}_s = 0),$$

$\mathbf{A}_0 = \mathbf{A}_{s0} + \delta\mathbf{A}_0$ ($\mathbf{A}_\sim = \text{Re} [\mathbf{A}_0 e^{-i\omega t}]$ — какой-либо из векторов $\mathbf{E}_\sim, \mathbf{H}_\sim, \mathbf{D}_\sim, \mathbf{j}_\sim$), причем

$$\delta\xi, \delta\varphi, \delta\mathbf{u} \propto e^{st} \cos \mathbf{k}\mathbf{r},$$

а коэффициенты пропорциональности суть соответственно $f_1(z), f_2(z), f(z)$; через \mathbf{k} и \mathbf{r} обозначены двумерные (в плоскости x, y) векторы; s — величина размерности обратного времени. В каком виде следует искать $\delta\mathbf{E}_0, \delta\mathbf{H}_0, \delta\mathbf{D}_0$ и $\delta\mathbf{j}_0$, будет ясно из дальнейшего. Момент наступления неустойчивости определяется условием $\text{Res} = 0$. Так как нас интересует вопрос о возникновении стационарной конвекции, положим и $\text{Im } s = 0$.

Векторы $\delta\mathbf{j}_0, \delta\mathbf{E}_0$ и \mathbf{E}_{s0} связаны соотношением

$$\delta\mathbf{j}_0 = \sigma_s \delta\mathbf{E}_0 + \sigma_s \sigma_s \delta\xi \mathbf{E}_{s0}, \quad (3)$$

которое получается варьированием формулы $\mathbf{j}_0 = \sigma \mathbf{E}_0$ около статического решения.

Чтобы найти $\delta\mathbf{E}_0$, надо решить уравнения Максвелла. Варьируя последние около статического решения, получаем

$$\text{rot } \delta\mathbf{H}_\sim = \frac{4\pi}{c} \delta\mathbf{j}_\sim + \frac{\varepsilon_l}{c} \frac{\partial \delta\mathbf{E}_\sim}{\partial t}; \quad (4)$$

$$\text{rot } \delta\mathbf{E}_\sim = - \frac{1}{c} \frac{\partial \delta\mathbf{H}_\sim}{\partial t}; \quad (5)$$

$$\text{div } \delta\mathbf{H}_\sim = \text{div } \delta\mathbf{E}_\sim = 0. \quad (6)$$

При этом учтено, что в условиях $\omega\tau_{ee} \gg 1$ электронная температура ξ_s , а с ней и концентрация свободных носителей заряда n и объемная плотность заряда $\rho^{\text{своб}}$ не зависят от времени.

Согласно (3) и (6) $\delta\mathbf{E}_0$ следует искать в виде

$$\delta E_{0x}, \delta E_{0y} \propto \cos \mathbf{k}\mathbf{r}, \quad \delta E_{0z} \propto \sin \mathbf{k}\mathbf{r};$$

коэффициенты пропорциональности соответственно равны $\mathcal{E}_{0x}(z), \mathcal{E}_{0y}(z)$ и $\mathcal{E}_{0z}(z)$. При этом уравнения (4), (5) и (6) дают

$$\left(\frac{d^2}{dz^2} + \mathcal{K}_s^2 \right) \mathcal{E}_0 = \Psi_s, \quad (7)$$

где

$$\mathcal{K}_s^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \left[\epsilon_i + i \frac{4\pi\sigma_s}{\omega} - \frac{k^2 c^2}{\omega^2} \right], \quad \Psi_s = \left\{ \Psi_s = -i \frac{4\pi\omega}{c^2} \sigma_s \dot{\sigma}_{s1} E_{s0}, 0, 0 \right\}.$$

Граничное условие к уравнению (7) при $z \rightarrow \infty$ имеет вид

$$\mathcal{E}_0|_{z \rightarrow \infty} \rightarrow 0.$$

Значения констант $\mathcal{E}_{m\alpha} = \mathcal{E}_{0\alpha}|_{z=0}$ ($\alpha = x, y, z$) определяются из граничных условий к уравнениям Максвелла при $z=0$. Эти условия получаются, если проварьировать около статического решения (при постоянных $\underline{E}^{\text{пад}}$ и $\underline{H}^{\text{пад}}$) обычные граничные условия электродинамики. Мы имеем

$$\delta E_{m\alpha}^{\text{отр}} = \delta E_{m\alpha} \quad (\alpha = x, y); \quad (8)$$

$$\epsilon_d \delta E_{mz}^{\text{отр}} = \epsilon_i \delta E_{mz}; \quad (9)$$

$$\delta H_{m\beta}^{\text{отр}} = \delta H_{m\beta} \quad (\beta = x, y, z). \quad (10)$$

Здесь ϵ_d — диэлектрическая проницаемость диэлектрика, граничащего с полупроводником.

Необходимая для решения системы (8)–(10) связь между векторами $\delta \underline{E}_m$ и $\delta \underline{H}_m$ определяется, как обычно, из уравнений (5) и (7). Уравнение (7) решается по теории возмущений. Представим \mathcal{E}_0 в виде

$$\vec{\mathcal{E}}_0 = \vec{\mathcal{E}}_0^{(1)} + \vec{\mathcal{E}}_0^{(2)}, \quad \text{где } |\mathcal{E}_0^{(2)}| / |\mathcal{E}_0^{(1)}| \sim \xi_s \ll 1.$$

Тогда для $\vec{\mathcal{E}}_0^{(1)}$ имеем следующую краевую задачу:

$$\left(\frac{d^2}{dz^2} + \mathcal{K}_0^2 \right) \vec{\mathcal{E}}_0^{(1)} = \Psi_0;$$

$$\mathcal{E}_{0\alpha}^{(1)}|_{z=0} = \mathcal{E}_{m\alpha}^{(1)} \quad (\alpha = x, y, z);$$

$$\mathcal{E}_{0\alpha}^{(1)}|_{z \rightarrow \infty} \rightarrow 0,$$

где $\mathcal{K}_0^2 = \mathcal{K}_s^2$ ($\xi_s = 0$).

Величины $\vec{\mathcal{E}}_{0\alpha}^{(2)}$ мы искать не будем, поэтому индекс 1 в дальнейшем будем опускать. Решение поставленной выше краевой задачи имеет вид

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{0x} = & \mathcal{E}_{mx} e^{i\mathcal{K}_0 z} + \frac{i e^{i\mathcal{K}_0 z}}{2\mathcal{K}_0} \left[\int_0^\infty dz' e^{i\mathcal{K}_0 z'} \Psi_0(z') - \right. \\ & \left. - \int_0^z dz' e^{-i\mathcal{K}_0 z'} \Psi_0(z') - e^{-i2\mathcal{K}_0 z} \int_z^\infty dz' e^{i\mathcal{K}_0 z'} \Psi_0(z') \right]; \end{aligned}$$

$$\mathcal{E}_{0\alpha} = \mathcal{E}_{m\alpha} e^{i\mathcal{K}_0 z} \quad (\alpha = y, z).$$

При этом из уравнения (5) находим при $z=0$

$$(k_y \mathcal{E}_{mz} - \mathcal{K}_0 \mathcal{E}_{my}) \cos k\tau = q \delta H_{mx}; \quad (11)$$

$$\left(\mathcal{V}_0 \mathcal{E}_{mx} - \int_0^{\infty} dz' e^{i\mathcal{K}z'} \Psi_0(z') - k_x \mathcal{E}_{mx} \right) \cos kr = q \delta H_{my}; \quad (12)$$

$$- (k_x \mathcal{E}_{my} - k_y \mathcal{E}_{mx}) \sin kr = q \delta H_{mz}. \quad (13)$$

Оценка интеграла в формуле (12) показывает, что он мал по параметру $\gamma_0/\lambda_0 \ll 1$, поэтому его следует опустить. В силу уравнения (6) величины \mathcal{E}_{mx} , \mathcal{E}_{my} и \mathcal{E}_{mz} не независимы, а связаны соотношением

$$-k_x \mathcal{E}_{mx} - k_y \mathcal{E}_{my} + \mathcal{K}_0 \mathcal{E}_{mz} = 0. \quad (14)$$

Чтобы написать выражения типа (11)–(14) для отраженной волны, нужно во всех формулах положить $\sigma=0$ и произвести замену ε_l на ε_d и \mathcal{K}_0 на $-\mathcal{Q}_0 = -\omega c^{-1} (\varepsilon_d - k^2 c^2 \omega^{-2})^{1/2}$.

Легко убедиться при этом, что все необходимые условия удовлетворяются, лишь если

$$\mathcal{E}_{m\alpha} = \mathcal{E}_{m\alpha}^{\text{отр}} = \delta H_{m\alpha} = \delta H_{m\alpha}^{\text{отр}} = 0 \quad (\alpha = x, y, z).$$

Этот результат не должен вызывать удивления: как и в обычной линейной оптике, граничным условиям нельзя удовлетворить, рассматривая только две волны.

Уравнение баланса энергии удобно решать в безразмерных переменных. Будем считать, что длина измерена в единицах λ_0^{-1} , время — в единицах τ_0 , скорость — в $u_0 = 3/(5+2r)\lambda_0\tau_0$, электрическое поле — в $3T_0/2\varepsilon_0 u_0$, интенсивность света — в $3nT_0/2\lambda_0\tau_0$. Тогда варьируя уравнение (1) около статического решения, линеаризуя его по ξ и отбрасывая слагаемые, малые по параметрам γ_0 и γ_0^2 , получаем

$$f_1'' - [k^2 + 1 - (2\dot{\tau}_0 + \dot{x}_0) \xi_s] f_1 = -\dot{\sigma}_{r0} \gamma_0 I_m e^{-\gamma_0 z} f_1 - \gamma_0 I_m e^{-\gamma_0 z} (\mathcal{E}_{0x}/E_{s0} + \text{K. C.}). \quad (15)$$

При $\dot{\sigma}_{r0}=0$ уравнение (15) переходит в соответствующее уравнение работы [1]. Уравнение (15) мы будем решать в двух областях: $z \ll \gamma_0^{-1}$ (при этом $\xi_s \simeq \gamma_0 I_m$) и $z \gg \gamma_0^{-1}$ (здесь $\xi_s \simeq \gamma_0 I_m e^{-\gamma_0 z}$). Оценка правой части уравнения (при этом в качестве f_1 берется его нулевое приближение — функция, найденная в [1]) показывает, что она мала, и мы ее отбросим. В области $z \ll \gamma_0^{-1}$ получаем

$$f_1(z) = A \cos \lambda z + B \sin \lambda z, \quad (16)$$

где

$$\lambda^2 = (2\dot{\tau}_0 + \dot{x}_0 + \dot{\sigma}_{r0}) \gamma_0 I_m - k^2 - 1 = q_0^2 - k^2 - 1.$$

В области же $z \gg \gamma_0^{-1}$ (с учетом условия $T \rightarrow T_0$ при $z \rightarrow \infty$) находим

$$f_1(z) = C J_p \left(\frac{2q_0}{\gamma_0} e^{-\gamma_0 z/2} \right), \quad (17)$$

где $p = 2\gamma_0^{-1} (1 + k^2)^{1/2}$.

Волновой вектор сверхрешетки k , а с ним и критическую интенсивность $I_m^{\text{кр}}$ найдем из граничного условия к уравнению (15) при $z=0$ и условия сшивания решений (16) и (17) в некоторой точке $z_0 \leq \gamma_0^{-1}$. Оказывается, что получающиеся при этом значения k и $I_m^{\text{кр}}$ не зависят от точки сшивания z_0 *

* Мое внимание на это обратил В. Л. Бонч-Бруевич.

Первое из указанных условий имеет вид:

$$z = 0: f_1 = v'_{эф} f_1,$$

где

$$v'_{эф} = v_0 [1 - (2v'_0 + \kappa_0) \gamma_0 I_m] (1 - \kappa_0 \gamma_0 I_m)^{-1}. \quad (18)$$

Из формул (16) — (18) и условия сшивания решений в точке z_0 с точностью до величин $\sim \gamma_0^2$ получаем $\gamma_0 I_m (2\tau_0 + \kappa_0 + \sigma_{r0}) = 1 + k^2$ и, следовательно,

$$k = \sqrt{\frac{I_m}{I_m^{кр}} - 1},$$

где

$$I_m^{кр} = \frac{1}{\gamma_0 (2\tau_0 + \kappa_0 + \sigma_{r0})} \quad (19)$$

есть минимальное значение интенсивности, при котором наступает неустойчивость.

Феноменологически учет зависимости коэффициента поглощения света от электронной температуры проявляется в том, что становится несправедливой формула $I = I_m e^{-\gamma z}$, использованная в работе [1]. Для установления истинной зависимости пришлось решать уравнения Максвелла. Оказывается, что если вместо этого просто положить

$$I = I_m \exp \left\{ - \int_0^z \gamma(z') dz' \right\} \quad (\text{что непосредственно следует из определе-}$$

ния коэффициента поглощения), то получится тот же результат с той лишь разницей, что в формуле (19) вместо σ_{r0} будет стоять γ_0 . Однако такой подход представляется менее убедительным, чем решение уравнений электродинамики, поскольку в нем отсутствует рецепт вычисления функции $\gamma(T)$, а с ней и величин γ_0 и γ_0 .

Из формулы (19) видно, что при $\sigma_{r0} = 0$, т. е. в отсутствие зависимости коэффициента поглощения от электронной температуры она переходит в соответствующую формулу работы [1]. При $\sigma_{r0} > 0$, как и ожидалось, мы получим несколько меньшие значения $I_m^{кр}$, чем в [1], а при $\sigma_{r0} < 0$ — несколько большие. Если в полупроводнике импульс электронов рассеивается в основном на заряженной примеси, а энергия — на пьезоэлектрических акустических фононах, то $\gamma_0 I_m^{кр}$ будет равно $1/5$, а не $1/3,5$ (как было бы при $\sigma_{r0} = 0$).

В заключение считаю своим долгом выразить глубокую благодарность В. Л. Бонч-Бруевичу за предоставление интересной темы, внимание и большую помощь в работе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бонч-Бруевич В. Л. ЖЭТФ, 1974, 67, 2204.
2. Басс Ф. Г., Гуревич Ю. Г. Горячие электроны и сильные электромагнитные волны в плазме полупроводников и газового разряда. М., 1975.

Поступила в редакцию
04.04.78